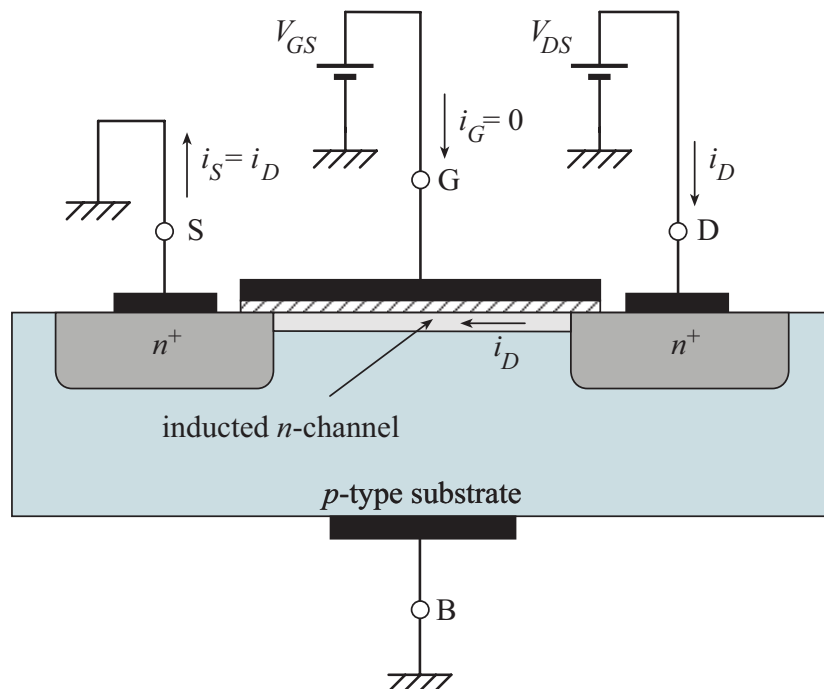


Transistor NMOS ad arricchimento con una tensione positiva applicata al gate. Un canale di tipo *n* è indotto sulla superficie della regione del substrato in corrispondenza del gate.



Transistor NMOS con $V_{GS} > V_{TH}$ ed una debole V_{DS} applicata. Il dispositivo si comporta come una conduttanza il cui valore è determinato da V_{GS} . In particolare, la conduttanza del canale è proporzionale a $V_{GS} - V_{TH}$ e la corrente I_D è proporzionale a $(V_{GS} - V_{TH})V_{DS}$, (per semplicità la regione di svuotamento non è mostrata).